

关于《碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管（SiC MOSFET）功率循环试验方法》等 2 项团体标准征求意见的通知

各有关单位：

由工业和信息化部电子第五研究所提出，并主责起草的《碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管（SiC MOSFET）功率循环试验方法》和《碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管（SiC MOSFET）结壳热阻瞬态双界面测试方法》两项团体标准已完成征求意见稿的编制，根据《CASAS 管理和标准制修订细则》有关规定，为保证标准的科学性、严谨性和适用性，现公开征求意见。

请各有关单位及专家对本标准提出宝贵建议和意见，于 2021 年 11 月 30 日前以邮件的形式将《团体标准征求意见反馈表》反馈至联盟秘书处。

特此通知。

北京第三代半导体产业技术创新战略联盟

2021 年 11 月 3 日

秘书处邮箱：casas@casa-china.cn

秘书处电话：010-82387600-208